

SF 225

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-Transistor für HF-Verstärker für LMK-Vor- und ZF-Stufen in Emitterschaltung.

Bauform 7 E-Line C-E-B

Wärmewiderstand $R_{thj\alpha} \leq 0,5 \text{ K/mW}$

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

U_{CBO}	$= 40 \text{ V}$	P_{tot} ($\vartheta_{\alpha} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	$\leq 200 \text{ mW}$
U_{CEO}	$= 25 \text{ V}$	ϑ_{α}	$-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +100 \text{ }^{\circ}\text{C}$
U_{EBO}	$= 4 \text{ V}$	ϑ_j	$+125 \text{ }^{\circ}\text{C}$
I_C	$= 25 \text{ mA}$		

Elektrische Kennwerte (für $\vartheta_{\alpha} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C} - 5 \text{ K}$)

I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 40 \text{ V}$)	$\leq 0,5 \text{ } \mu\text{A}$
$U_{(BR)CEO}^{1)}$	(bei $I_C = 1 \text{ mA}$)	$\leq 25 \text{ V}$
$U_{(BR)EBO}$	(bei $I_E = 10 \text{ } \mu\text{A}$)	$\leq 4 \text{ V}$
I_B	(bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}$)	$\leq 25 \text{ } \mu\text{A}$
$-C_{12e}$	(bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA},$ $f = 10,7 \text{ MHz}$)	$\leq 0,6 \text{ pF}$
F	(bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA},$ $f = 200 \text{ MHz}, R_g = 300 \text{ Ohm}$).	$\leq 5 \text{ dB}$
f_T	(bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA},$ $f = 100 \text{ MHz}$)	typ. 500 MHz
$\frac{I_{h21 b I}}{\omega}$	(bei $U_{CB} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA},$ $f = 30 \text{ MHz}$)	typ. 29 ps
$h_{21 E}$	(bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}$) (typ. 70)	≥ 40

1) Messung erfolgt impulsmäßig